

P-I-N-ДИОДЫ В ПЛАСТИКОВЫХ КОРПУСАХ

| Тип | St max., пФ | @Vr, В | Rs max., Ом | @ If, мА | Vr max, В | τ ⁷⁾ , мкс | R θ , °C/Вт | Pdiss, Вт | Корпус |
|--------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| MADP-011027-14150T | 0,35 | 50 | 2,6 | 10 | 100 | 1,0 | 45 | 3,3 ⁸⁾ | DFN-6 |
| MADP-011028-14150T | 0,30 | 50 | 4,4 | 10 | 200 | 2,0 | 35 | 4,3 ⁸⁾ | DFN-6 |
| MADP-011029-14150T | 0,40 | 50 | 1,9 | 10 | 400 | 1,0 | 20 | 7,5 ⁸⁾ | DFN-6 |
| MADP-010630-13920T | 0,35 | 20 | 1,5 ⁴⁾ | 10 | 100 | 0,2 | 82 | 25 ⁹⁾ | 1392 |
| MADP-010631-13920T | 1,00 | 20 | 0,5 ⁴⁾ | 10 | 100 | 0,2 | 32 | 40 ⁹⁾ | 1392 |
| MADP-010633-13920T | 0,40 | 50 | 0,6 ⁴⁾ | 100 | 500 | 1,0 | 25 | 100 ⁹⁾ | 1392 |
| MADP-011037-13900T | 0,3 тип. ¹⁾ | 50 | 0,3 дБ ⁶⁾ | 25 | 400 | 1,0 | 30 | 125 ⁹⁾ | QFN-16 |
| MADP-011104 | 0,45 тип. ²⁾ | 40 | 1,08 тип. ⁵⁾ | 50 | 800 | 2,0 | 10 | 45 ⁹⁾ | QFN-12 |
| MADP-008120-12790T | 0,15 ³⁾ | 10 | 2,5 | 10 | 100 | 0,2 | - | - | SC-79 |

St измерена на частоте 1 МГц, ¹⁾ 1 ГГц, ²⁾ 15 МГц, ³⁾ 100 МГц. Rs измерена на частоте 1 ГГц, ⁴⁾ 100 МГц, ⁵⁾ 3 ГГц.

⁶⁾ Вносимые потери последовательно включенного диода на частоте 1,25 ГГц.

⁷⁾ Время жизни носителей.

⁸⁾ При бесконечном теплоотводе с температурой 25°C.

⁹⁾ Максимальная падающая мощность в непрерывном режиме.

МОЩНЫЕ P-I-N-ДИОДЫ В КЕРАМИЧЕСКИХ ГЕРМЕТИЧНЫХ КОРПУСАХ SMQ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

| Тип | Cmax, пФ | @Vr, В | Rs max, Ом | @ If, мА | Пред. параметры | | | τ ¹⁾ , мкс | Δi ²⁾ , мкм | Назначение | Корпус |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | Vr, В | Pdiss, Вт | Pпад., Вт | | | | |
| MA4P1250-1072T | 1,2 | 50 | 0,75 | 50 | 50 | 6 / 18 ³⁾ | | 8,0 | - | Общ. назначения | 1072 ⁵⁾ |
| MA4P1450-1091T | 2,5 | 50 | 0,75 | 50 | 50 | 10 / 30 ³⁾ | | 8,0 | - | | 1091 |
| MA4PH235-1072T | 1,2 | 10 | 0,5 | 10 | 35 | 1,0 | | 0,3 | 10 | Переключатель | 1072 |
| MADP-000235-10720T | 1,2 | 10 | 0,5 | 10 | 35 | 7,5 | | 0,3 | 10 | Защита, подстройка | 1072 ⁶⁾ |
| MA4PH236-1072T | 0,5 | 10 | 3,0 | 10 | 600 | 1,0 | | 1,5 | 50 | Переключатель | 1072 |
| MA4PH237-1079T | 1,5 | 10 | 0,6 | 50 | 200 | 2,0 | | 3,0 | 75 | | 1079 |
| MA4PH238-1072T | 0,5 | 10 | 6,0 | 10 | 200 | 1,0 | | 2,0 | 100 | Аттенуатор | 1072 |
| MA4PH239-1079T | 0,8 | 10 | 25,0 | 10 | 200 | 2,0 | | 6,0 | 350 | | 1079 |
| MA4PH611-1091T | 1,1 | 50 | 0,45 | 100 | 1000 | 3,5 / 10 ³⁾ | | 5,0 | | Переключатель высоковольтный | 1091 |
| MA4P504-1072T | 0,5 | 100 | 0,6 | 100 | 500 | 2,9 / 7,5 ³⁾ | | 1,0 | 50 | | 1072 |
| MADP-000504-10720T | 0,5 | 100 | 0,6 | 100 | 500 | 2,9 / 7,5 ³⁾ | | 1,0 | 44 | 1072 ⁶⁾ | |
| MADP-011034-10720T | 1,5 | 0 | 0,5 | 10 | 150 | 6 ³⁾ | | 0,3 | 11 | Защита, подстройка | 1072 ⁶⁾ |
| MADP-007417-10720T | 0,7 | 100 | 0,8 | 100 | 1000 | 4 / 12 ³⁾ | 200 | 6,5 | 140 | Общ. назначения | 1072 |
| MADP-000234-10720T | 1,5 | 100 | 0,25 | 100 | 500 | 5 | | 3,0 | 50 | Переключатель | 1072 |
| MADP-000404-10720T | 0,6 | 50 | 0,7 | 50 | 250 | 7,5 | | 1,0 | 30 | | 1072 ⁶⁾ |
| MA4P505-1072T | 0,65 | 100 | 0,45 | 100 | 500 | 15 | | 2,0 | 50 | Высоковольтный | 1072 |
| MA4P506-1072T | 1,0 | 100 | 0,3 | 100 | 500 | 15 | | 3,0 | 50 | | 1072 |
| MA4P4001F-1091T | 2,2 | 100 | 0,5 | 100 | 100 | 7,5 ³⁾ | | 20 ⁴⁾ | 175 | Аттенуатор | 1091 |
| MA4P4002F-1091T | | | | | 200 | | | | | | |
| MA4P4006F-1091T | | | | | 600 | | | | | | |
| MA4P4301F-1091T | 2,0 | 100 | 1,0 | 100 | 100 | 5,0 ³⁾ | | 15 ⁴⁾ | 300 | Аттенуатор | 1091 |
| MA4P7001F-1072T | 0,7 | 100 | 0,9 | 100 | 100 | 10 ³⁾ | | 5 ⁴⁾ | 175 | Общ. назначения | 1072 |
| MA4P7002F-1072T | | | | | 200 | | | | | | |
| MA4P7006F-1072T | | | | | 600 | | | | | | |
| MA4P7101F-1072T | 1,0 | 100 | 0,5 | 100 | 100 | 11,5 ³⁾ | | 2,5 ⁴⁾ | 100 | Общ. назначения | 1072 |
| MA4P7102F-1072T | | | | | 200 | | | | | | |
| MA4P7104F-1072T | | | | | 400 | | | | | | |
| MA4P7418-1072T | 0,8 | 100 | 1,2 | 100 | 1100 | 4 / 11,5 ³⁾ | 200 | 7 | 140 | Переключатель | 1072 |
| MA4P7435NM-1091T | 3,0 | 100 | 0,25 | 200 | 1100 | 30 ³⁾ | 1000 | 14 | | | 1091 ⁶⁾ |
| MA4P7441F-1091T | 2,2 | 100 | 0,5 | 100 | 100 | 9 / 30 ³⁾ | 200 | 18 | 175 | | 1091 ⁶⁾ |
| MA4P7446F-1091T | 2,2 | 100 | 0,5 | 100 | 600 | 8 / 25 ³⁾ | 500 | 19 | 175 | | 1091 ⁶⁾ |
| MA4P7452F-1072T | 0,7 | 100 | 0,9 | 100 | 150 | 4 / 10 ³⁾ | 100 | 9 | 175 | | 1072 ⁶⁾ |
| MA4P7461F-1072T | 1,0 | 100 | 0,5 | 100 | 100 | 3 / 8 ³⁾ | 100 | 6 | 100 | | 1072 ⁶⁾ |
| MA4P7464F-1072T | 0,8 | 100 | 0,5 | 100 | 400 | 2,5 / 7,5 ³⁾ | 100 | 4,5 | 100 | | 1072 ⁶⁾ |
| MA4P7470F-1072T | 0,7 | 100 | 0,8 | 100 | 800 | 4 / 12 ³⁾ | 200 | 6,5 | 140 | | 1072 ⁶⁾ |

¹⁾ Время жизни носителей. ²⁾ Толщина i-слоя. ³⁾ При температуре контактной поверхности 25 °C. ⁴⁾ Минимальное значение.

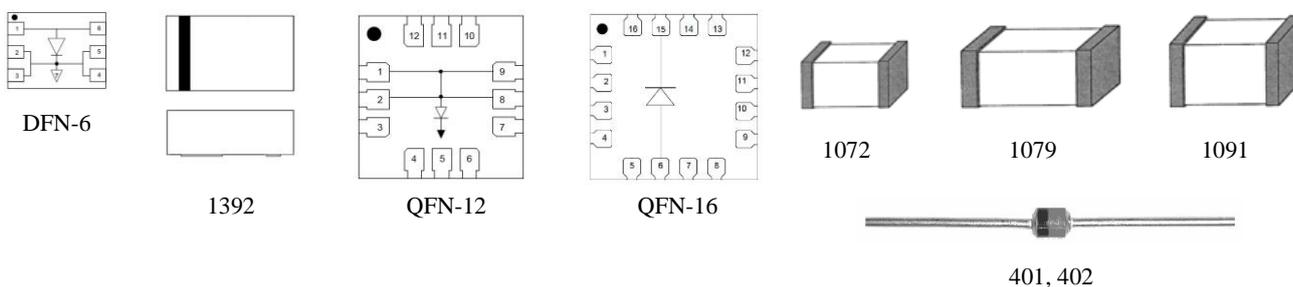
⁵⁾ Выпускаются также в немагнитном исполнении (NM). ⁶⁾ Немагнитный корпус.

St измерена на частоте 1 МГц, Rs – на частоте 100 МГц.

МОЩНЫЕ P-I-N-ДИОДЫ В КЕРАМИЧЕСКИХ ГЕРМЕТИЧНЫХ КОРПУСАХ С АКСИАЛЬНЫМИ ВЫВОДАМИ

| Тип | Cmax, пФ | @ Vr, В | Rs max, Ом | @ If, mA | Пред. параметры | | τ^1 , мкс | Δi^2 , мкм | Назначение | Корпус |
|--|----------|---------|------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------|
| | | | | | Vr, В | Pdiss, Вт | | | | |
| MA4P1200-401T* | 1,5 | 50 | 0,75 | 50 | 50 | 1,5 / 5,5 ³⁾ | 8,0 | - | Общ. назначения | 401 |
| MA4P4001B-402* MA4P4002B-402 MA4P4006B-402 | 2,2 | 100 | 0,5 | 100 | 100 200 600 | 2,5/12 ³⁾ | 20 ⁴⁾ | 175 | Аттенюатор | 402 |
| MA4P4301B-402 MA4P4302B-402 | 2,0 | 100 | 1,0 | 100 | 100 200 | 2,5/10 ³⁾ | 15 ⁴⁾ | 300 | Аттенюатор | 402 |
| MA4P7002B-401T MA4P7006B-401T | 0,7 | 100 | 0,9 | 100 | 200 600 | 1,5 / 5,0 ³⁾ | 5 ⁴⁾ | 175 | Общ. назначения | 401 |
| MA4P7101B-401T MA4P7102B-401T MA4P7104B-401T | 1,0 | 100 | 0,5 | 100 | 100 200 400 | 1,5/6,0 ³⁾ | 2,5 ⁴⁾ | 100 | Переключатель | 401 |

¹⁾ Время жизни носителей. ²⁾ Толщина i-слоя. ³⁾ При температуре контактной поверхности 25 °С. ⁴⁾ Минимальное значение.
* Выпускаются также в немагнитном исполнении (NM). Ct измерена на частоте 1 МГц, Rs – на частоте 100 МГц.



МОЩНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ P-I-N-ДИОДЫ В МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ГЕРМЕТИЧНЫХ КОРПУСАХ

| Тип | Cmax, пФ | @ Vr, В | Rs max, Ом | @ If, mA | Пред. параметры | | | τ^1 , мкс | Δi^2 , мкм | Корпус |
|------------------|----------|---------|------------|----------|-----------------|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | | | Vr, В | If, A | Pdiss, Вт | | | |
| MA4PK2000 | 3,2 | 100 | 0,2 | 500 | 2000 | 25 | | 30 | 200 | 1027 |
| MA4PK2001 / 2002 | | | | | | | 50 | | | 1082 / 1048 |
| MA4PK2003 / 2004 | | | | | | | 37,5 | | | 1080 / 1038 |
| MA4PK3000 | 4,0 | 100 | 0,25 | 500 | 3000 | 25 | | 65 | 325 | 1073 |
| MA4PK3001 / 3002 | | | | | | | 75 | | | 1084 / 1074 |
| MA4PK3003 / 3004 | | | | | | | 50 | | | 1085 / 1075 |

¹⁾ Время жизни носителей (мин.). ²⁾ Толщина i-слоя.
Ct измерена на частоте 1 МГц, Rs – на частоте 4 МГц.

| Типы корпусов: | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|--|--------------------------|
| Корпус | Цилиндрический без винта | С винтом и контактом под пайку | С винтом | С изолированным винтом и контактом под пайку * | С изолированным винтом * |
| Cp=0,45 пФ Ls=2 нГн | 1027 | 1082 | 1048 | 1080 | 1038 |
| Cp=0,75 пФ Ls=3 нГн | 1073 | 1084 | 1074 | 1085 | 1075 |

* Емкость на корпус 1,1 пФ

P-I-N-ДИОДЫ В ПРОЧИХ КОРПУСАХ

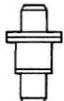
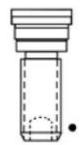
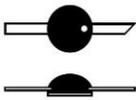
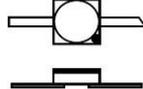
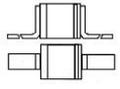
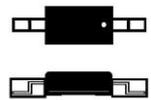
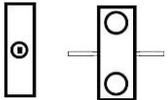
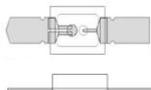
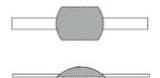
| Тип | С _{max} , пФ | @V _r , В | R _s max, Ом | @ I _f , мА | V _r , В | R _θ , °С/Вт | τ ¹⁾ , мкс | Δi ²⁾ , мкм | Корпуса |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| МА4Р202-120 | 0,25 | 10 | 2,5 ³⁾ | 10 | 100 | 60 | 0,06 | 12 | 120, 276 |
| МА4Р203-30 | 0,35 | 10 | 1,5 ³⁾ | 10 | 100 | 30 | 0,1 | 12 | 30, 1056 |
| МА4Р303-120 | 0,30 | 10 | 1,5 ³⁾ | 10 | 200 | 30 | 0,2 | 20 | 120, 186, 1088 |
| МА4Р404-30 | 0,40 | 50 | 0,70 | 50 | 250 | 20 | 1 | 30 | 30, 258 |
| МА4Р504-30 | 0,40 | 100 | 0,60 | 100 | 500 | 10 ³⁾ | 1 | 40 | 30, 120, 144, 186, 255 |
| МА4Р505-36 МАДР-000015- 000030 | 0,55 | 100 | 0,45 | 100 | 500 | 15 ³⁾ | 2 | 50 | 36, 255 30 |
| МА4Р506-30 | 0,90 | 100 | 0,30 | 100 | 500 | 15 ³⁾ | 3 | 50 | 30, 31, 255, 258 |
| МА4Р604-30 | 0,50 | 100 | 1,00 | 100 | 1000 | 15 ³⁾ | 3 | 95 | 30, 255, 258 |
| МА4Р606-30 | 0,80 | 100 | 0,70 | 100 | 1000 | 20 ³⁾ | 4 | 95 | 30, 36, 258 |
| МА4Р607-43 | 2,0 | 100 | 0,40 | 100 | 1000 | 25 ³⁾ | 12 | 125 | 43, 296 |
| МА4Р709-150 | 3,3 | 100 | 0,25 | 200 | 1500 | 2 | 10 | 200 | 150 |
| МА4РВL027 | 0,04 | 10 | 4,0 | 10 | 90 | 0,15 ³⁾ | 0,15 | - | Beam Lead |

¹⁾ Время жизни носителей (мин.). ²⁾ Толщина i-слоя. ³⁾ Максимальная рассеиваемая мощность, Вт.

P-I-N-ДИОДЫ В СТЕКЛЯННЫХ КОРПУСАХ С АКЦИАЛЬНЫМИ ВЫВОДАМИ

| Тип | С _{max} , пФ | @V _r , В | R _s max, Ом | @ I _f , мА | Пред. параметры | | τ ¹⁾ , мкс | Δi ²⁾ , мкм | Корпус |
|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|
| | | | | | V _r , В | P _{diss} , Вт | | | |
| МА47047-54 | 0,30 | 50 | 3,0 | 10 | 200 | 0,25 | 1,0 | 50 | 54 |
| МА47120-54Т | 1,0 | 20 | 0,5 | 10 | 35 | | 3,0 | 10 | |
| МА47600-54 | 0,30 | 50 | 6,0 | 10 | 200 | | 2,0 | 100 | |
| МА4Р203-54 | 0,25 | 10 | 1,5 | 10 | 100 | | 0,1 | 20 | |
| МА4Р404-54 | 0,30 | 50 | 0,7 | 50 | 250 | | 1,0 | 25 | |
| МА4РН401-54Т | 0,30 | 20 | 1,5 | 10 | 50 | | 1,0 | 50 | |
| МА47123-139 | 0,50 | 50 | 3,0 | 10 | 200 | 0,5 | 1,0 | 50 | 139 |
| МА4РН151-139Т | 1,2 | 50 | 0,6 | 10 | 100 | | 1,0 | 20 | |
| МА47266-146 | 1,50 | 50 | 0,6 | 50 | 200 | 1,0 | 4,0 | 75 | 146 |
| МА4РН301 | 1,10 | 50 | 1,0 | 50 | 200 | | 4,0 | 75 | |
| МА4Р506-4 | 0,85 | 100 | 0,30 | 100 | 500 | 1,0 | 2,5 | 50 | 4 |
| МА4Р606-4 | 0,70 | 100 | 0,70 | 100 | 1000 | | 4,0 | 100 | |
| МАДР-009989-14320Т | 1,2 тип. | 0 | - | - | 75 | 4,0 | 6,5 | - | 1432 |
| МАДР-009989-14340Т | | | | | | 1,0 | | | 1434 |

¹⁾ Время жизни носителей (мин.). ²⁾ Толщина i-слоя.
Емкости диодов приведены для типа корпуса, указанного в наименовании.
С_t измерена на частоте 1 МГц, R_s – на частоте 100 МГц, ³⁾ 500 МГц.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 30 C _p =0,18 пФ L _s =0,40 нГн | 31 C _p =0,18 пФ L _s =0,60 нГн | 36 C _p =0,18 пФ L _s =0,40 нГн | 120 C _p =0,13 пФ L _s =0,40 нГн | 43 C _p =0,75 пФ L _s =0,60 нГн | 258 C _p =0,18 пФ |
| 296 C _p =0,35 пФ | 32 C _p =0,30 пФ L _s =0,40 нГн | | 255 C _p =0,30 пФ L _s =0,40 нГн | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 137 C _p =0,14 пФ L _s =0,70 нГн | 186 C _p =0,15 пФ L _s =0,70 нГн | 276 C _p =0,13 пФ L _s =0,40 нГн | 1056 C _p =0,20 пФ L _s =0,70 нГн | 1088 C _p =0,12 пФ L _s =0,70 нГн | 144 C _p =0,42 пФ |
|  |  |  |  |  |  |
| 150 | 4, 54, 139, 146 | 1432 | 1434 | Beam Lead | 1134 |

БЕСКОРПУСНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ P-I-N-ДИОДЫ

| Тип | С _т max, пФ | @V _r , В | R _s max, Ом | @ I _f , мА | V _r , В | R _θ , °С/Вт | τ ¹⁾ , мкс | Δi ²⁾ , мкм | Размер чипа, мм ² |
|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| MA4P161-134 | 0,1 | 10 | 1,5 | 10 | 100 | 65 | 0,15 | 13 | 0,33 x 0,33 |
| MA4P203-134 | 0,15 | 10 | 1,5 | 10 | 100 | 30 | 0,15 | 13 | 0,33 x 0,33 |
| MA4P7493-134 | 0,05 | 10 | 1,8 | 10 | 150 | 60 | 0,08 | 19 | 0,33 x 0,33 |
| MA4P303-134 | 0,15 | 10 | 1,5 | 10 | 200 | 30 | 0,3 | 20 | 0,33 x 0,33 |
| MA4P404-132 | 0,20 | 50 | 0,7 | 50 | 250 | 20 | 0,6 | 30 | 0,51 x 0,51 |
| MADP-000165-01340 | 0,06 | 10 | 2,5 | 10 | 200 | 30 | 0,2 | 19 | 0,33 x 0,33 |
| MADP-000135-01340 | 0,15 | 10 | 1,2 | 10 | 200 | 30 | 0,44 | 19 | 0,33 x 0,33 |
| MA47416-132 | 0,15 | 100 | 6,0 ³⁾ | 10 | 200 | 30 | 2 | 100 | 0,48 x 0,48 |
| MA47418-134 | 0,15 | 100 | 3,0 ³⁾ | 10 | 200 | 25 | 1 | 50 | 0,33 x 0,33 |
| MA4P504-132 | 0,2 | 100 | 0,6 ³⁾ | 100 | 500 | 20 | 1 | 50 | 0,51 x 0,51 |
| MA4P505-131 | 0,35 | 100 | 0,45 ³⁾ | 100 | 500 | 14 | 2 | 50 | 0,69 x 0,69 |
| MA4P506-131 | 0,7 | 100 | 0,3 ³⁾ | 100 | 500 | 11 | 3 | 50 | 0,69 x 0,69 |
| MADP-000488-13740 | 0,19 | 50 | 1,6 ³⁾ | 50 | 900 | 45 | 4 | 140 | 0,58 x 0,58 |
| MA4P604-131 | 0,3 | 100 | 1,0 ³⁾ | 100 | 1000 | 10 | 3 | 90 | 0,69 x 0,69 |
| MA4P606-131 | 0,6 | 100 | 0,7 ³⁾ | 100 | 1000 | 8 | 4 | 90 | 0,81 x 0,81 |
| MA4P607-212 | 1,3 | 100 | 0,4 ³⁾ | 100 | 1000 | 4 | 12 | 127 | 1,57 x 1,57 |
| MA4PK3000-1252 | 2,9 | 100 | 0,25 ⁴⁾ | 500 | 3000 | 1,5 | 60 | 350 | 4,37 x 4,37 |

1) Время жизни носителей. 2) Толщина i-слоя. С измерена на частоте 1 МГц, R_s - на частоте 500 МГц, 3) 100 МГц, 4) 4 МГц.

БЕСКОРПУСНЫЕ P-I-N-ДИОДЫ FLIP-CHIP

| Тип | С _т тип., пФ | @V _r , В | R _s тип., Ом | @ I _f , мА | V _r , В | R _θ , °С/Вт | τ ¹⁾ , мкс | P _{diss} , Вт | Размер чипа, мм ² |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| MA4FCP200 | 0,02 | 40 | 2,8 | 50 | 70 | 900 | 0,1 | 0,1 | 0,37 x 0,21 |
| MA4FCP300 | 0,025 | 10 | 2,6 | 50 | 100 | 450 | 0,14 | 0,15 | 0,71 x 0,37 |
| MA4FCP305 | 0,05 | 10 | 2,1 | 50 | 40 | 640 | 0,025 | 0,23 | 0,71 x 0,37 |
| MA4SPS302 | 0,36 | 40 | 1,3 ²⁾ | 10 | 100 | 125 | 0,46 | 0,8 | 1,37 x 0,56 |
| MA4SPS402 (MADP-000402-12530) | 0,045 | 40 | 5 | 10 | 100 | 150 | 0,20 | 1,0 | 1,23 x 0,48 |
| MA4SPS421 (MADP-000421-12940) | 0,07 | 40 | 6,2 | 10 | 200 | 80 | 5 | 1,8 | 1,05 x 0,55 |
| MA4SPS422 (MADP-000422-12950) | 0,13 | 40 | 3,1 | 10 | 200 | 70 | 10 | 1,8 | 1,05 x 0,55 |
| MA4SPS502 | 0,09 | 40 | 1,4 ²⁾ | 100 | 275 | 50 | 2,8 | 3,0 | 1,52 x 0,71 |
| MA4SPS552 | 0,06 | 40 | 1,7 ²⁾ | 100 | 200 | 30 | 2,5 | 1,0 | 0,55 x 0,30 |
| MADP-042305-13060 | 0,15 | 10 | 1,18 | 50 | 80 | 145 | 0,18 | 10 ³⁾ | 1,05 x 0,55 |
| MADP-042405-13060 | 0,61 | 10 | 0,58 | 50 | 80 | 100 | 0,255 | 25 ³⁾ | 1,05 x 0,55 |
| MADP-042505-13060 | 0,28 | 10 | 0,76 | 50 | 80 | 115 | 0,21 | 20 ³⁾ | 1,05 x 0,55 |
| MADP-042905-13060 | 0,06 | 10 | 2,60 | 50 | 80 | 185 | 0,14 | 7 ³⁾ | 1,05 x 0,55 |
| MADP-042308-13060 | 0,10 | 10 | 1,18 | 50 | 100 | 145 | 0,28 | 15 ³⁾ | 1,05 x 0,55 |
| MADP-042408-13060 | 0,39 | 10 | 0,61 | 50 | 100 | 100 | 0,38 | 25 ³⁾ | 1,05 x 0,55 |
| MADP-042508-13060 | 0,19 | 10 | 0,87 | 50 | 100 | 115 | 0,31 | 20 ³⁾ | 1,05 x 0,55 |
| MADP-042908-13060 | 0,05 | 10 | 3,02 | 50 | 100 | 185 | 0,23 | 8 ³⁾ | 1,05 x 0,55 |
| MADP-017015-13140 | 0,31 | 40 | 0,51 | 70 | 115 | 30 | 1,3 | 100 ³⁾ | 1,55 x 0,80 |
| MADP-030015-13140 | 0,78 | 40 | 0,38 | 70 | 115 | 13 | 1,6 | 100 ³⁾ | 1,55 x 0,80 |
| MADP-017025-13140 | 0,23 | 40 | 0,64 | 70 | 135 | 30 | 2,3 | 100 ³⁾ | 1,55 x 0,80 |
| MADP-030025-13140 | 0,50 | 40 | 0,45 | 70 | 135 | 13 | 2,8 | 100 ³⁾ | 1,55 x 0,80 |
| MADP-000208-13180* | 0,81 | 10 | 0,4 | 10 | 90 | 58 | 0,5 | 30 ³⁾ | 1,14 x 0,38 |
| MADP-064908-131000** | 0,04 | 40 | 5,0 | 10 | 100 | 150 | 0,2 | 3 ³⁾ | 1,55 x 0,94 |

1) Время жизни носителей. С_т измерена на частоте 1 ГГц, R_s – на частоте 1 ГГц 2) 100 МГц.

3) Максимальная падающая мощность в непрерывном режиме.

* Последовательная диодная пара ** Две отдельных последовательных диодных пары

ПАРЫ ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ P-I-N-ДИОДОВ В ОДНОМ КОРПУСЕ

| Тип | С _т max, пФ | @V _r , В | R _s тип., Ом | @ I _f , мА | Пред. параметры | | τ ¹⁾ , нс | Конфигурация | Корпус |
|-------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| | | | | | V _r , В | P _{diss} , Вт | | | |
| MA44781 | 3,5 | 0 | - | - | 60 | 2 | - | Сдвоенная пара | 1134* |
| MA45471 | 3,5 | 0 | - | - | 75 | 1,7 | 200 | Одна пара | 1134* |
| MADP-011048 | 4,0 | 0 | 0,5 | 10 | 80 | 4,7 | 200 | Две отдельные пары | QFN-8* |
| MADP-011084 | 3,0 | 0 | 1,0 | 10 | 50 | 4,0 | 55 | Два отдельных диода | QFN-8* |

* Немагнитные корпуса

GaAs P-I-N-ДИОДЫ

| Тип | Ct max, пФ | @ Vr, В | Rs max, Ом | @ If, mA | Vr max, В | P diss, мВт | τ ¹⁾ , нс (t пер., нс) | Материал, конструкция | Размеры мм |
|-------------------------------------|------------|---------|---------------------------|----------|-----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
| MA4GP022-277 | 0,15 | 10 | 1,0 | 20 | 50 | 250 | 20 | GaAs, chip | 0,28 x 0,28 |
| MA4GP030-277 MADP-000030-13930 | 0,06 | 10 | 2,0 | 20 | 100 | 250 | 25 | GaAs, chip Чип с выводами | 0,38 x 0,38 |
| MA4GP905 | 0,03 | 10 | 4,9 | 20 | 50 | 100 ³⁾ | 2 | GaAs, Beam-lead | 0,63 x 0,22 |
| MA4GP907 (MADP-000907-13050P) | 0,03 | 10 | 7,0 | 10 | 50 | 250 | (2) | GaAs, Flip-chip | 0,67 x 0,36 |
| MA4AGP907 (MADP-001907-13050P) | 0,03 | 5 | 4,2 ²⁾ тип. | 10 | 50 | 50 | (2) | AlGaAS, Flip-chip | 0,67 x 0,36 |
| MA4AGFCP910 (MADP-000910-13050P) | 0,021 | 10 | 6 ²⁾ | 10 | 75 | 50 | 4 (2) | AlGaAS, Flip-chip | 0,67 x 0,36 |
| MADP-000907-14020 | 0,03 | 10 | 7 | 10 | 45 | 100 | (2) | AlGaAS, Flip-chip | 0,76 x 0,39 |
| MA4AGBLP912 | 0,03 | 5 | 4,9 | 20 | 50 | 200 ³⁾ | 5 | AlGaAs, Beam Lead | 0,63 x 0,18 |

¹⁾ Время жизни носителей. Ct измерена на частоте 1 МГц, Rs - на частоте 1 ГГц, ²⁾ на частоте 10 ГГц.

³⁾ Максимальная падающая мощность в непрерывном режиме, мВт.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ P-I-N-ДИОДЫ

| Тип | Cmax, пФ @ Vr=0 | Rs max, Ом @ If=10 mA | Vbr ¹⁾ , В | τ ²⁾ , нс | Δi ³⁾ , мкм | Pin(пик.)@ f=9,4 ГГц ⁴⁾ | | | Время восст. ⁵⁾ , нс | Pin max пик. ⁶⁾ /непрер., Вт |
|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|---|
| | | | | | | 1 дБ | 10 дБ | 15 дБ | | |
| MA4L011-134 | 0,18 | 2,1 | 15 | 10 | 2 | 7 | 30 | 40 | 10 | 80 / 2 |
| MADL-011052 | 0,21 | 2,0 | 20 | 23 | 2 | 7 | 28 | 39 | 50 | 100 / 4 |
| MA4L021-134 | 0,20 | 2,1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 41 | 15 | 90 / 3 |
| MA4L022-134 | 0,19 | 2,0 | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 41 | 15 | 90 / 3 |
| MADL-011021 | 0,24 | 2,0 | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 41 | 10 | 90 / 3 |
| MA4L031-134 | 0,21 | 2,0 | 30 | 20 | 3 | 10 | 33 | 43 | 25 | 125 / 4 |
| MA4L032-134 | 0,20 | 2,5 | 30 | 15 | 3 | 11 | 34 | 44 | 25 | 125 / 4 |
| MADL-011010 | 0,24 | 1,5 | 30 | 15 | 3 | 11 | 34 | 44 | 25 | 125 / 4 |
| MADL-011054 | 0,16 | 1,6 | 60 | 74 | 4 | 13 | 37 | 48 | 100 | 200 / 6 |
| MA4L062-134 | 0,15 | 2,5 | 60 | 10 | 4 | 15 | 38 | 50 | 75 | 200 / 5 |
| MADL-011011 | 0,17 | 2,3 | 60 | 10 | 4 | 15 | 38 | 50 | 75 | 200 / 5 |
| MA4L101-134 | 0,15 | 2,0 | 100 | 90 | 13 | 20 | 45 | 53 | 100 | 250 / 6 |
| MADL-000301 | 0,20 | 1,5 | 200 | 200 | 20 | 23 | 46 | 59 | 50 | 500 / 7 |
| MA4L401-134 | 0,25 | 1,2 | 250 | 800 | 25 | 30 | 52 | 60 | 250 | 1000 / 10 |

Указаны параметры диодов в виде кристаллов. C измерена на частоте 1 МГц, Rs – на частоте 500 МГц.

¹⁾ Напряжение пробоя ²⁾ Время жизни носителей ³⁾ Толщина i-слоя ⁴⁾ Характеристики ограничения при параллельном включении в 50-омную линию ⁵⁾ До состояния с потерями, превышающими начальные на 3 дБ

⁶⁾ При длительности импульса 1 мкс и коэфф. заполнения 1%

| Базовый диод | Имеющиеся типы корпусов |
|--------------|--|
| MA4L011 | 30, 31, 32, 134 (чип), 137, 186, 1056, 1088, 1388 (MADL-000011-13880G) |
| MA4L021 | 31, 120, 134 (чип), 1056 |
| MA4L022 | 30, 32, 120, 134 (чип), 137, 186, 1056 |
| MA4L031 | 31, 134 (чип), 186, 1056, 1388 (MADL-000031-13880G) |
| MA4L032 | 30 (MADL-000032-003000), 31, 32, 134 (чип), 186, 1056 |
| MA4L062 | 134 (чип), 1056 (MADL-000062-105600), 1388 (MADL-000062-13880G) |
| MA4L101 | 30, 134 (чип), 186, 1388 (MADL-000101-13880G) |
| MA4L301 | 134 (MADL-000301-01340W, чип), 31, 1056, 1387 (MADL-000301-13870G) |
| MA4L401 | 30, 31, 120, 134 (чип), 1056, 186, 1056, 1088, MADL-000401-01320G (чип), 1387 (MADL-000401-13870G) |
| MADL-011010 | 134 (MADL-011010-01340W/G, чип) |
| MADL-011011 | 134 (MADL-011011-01340W/G, чип) |
| MADL-011021 | 1421 (MADL-011021-14210G, чип) |
| MADL-011052 | 1428 (MADL-011052-14280W, чип) |
| MADL-011054 | 134 (MADL-011054-01340W, чип) |

10.12.2019